

конкретних даних про те, які саме хімічні процеси виникають в зоні контакту ПНТМ та алмазного круга, які їхні наслідки, як впливають режими різання на величину сколів різальної кромки, її шорсткість та іншість, недостатньо розглянуті питання про вплив присадок, які можуть бути використані для поліпшення їх стійкості. Тому відшукання високоефективних технологічних способів забезпечення якості робочих поверхонь інструментів з ПНТМ, реалізація яких була б можливою в умовах сучасного інструментального виробництва, має принципове значення.

## SUMMARY

The methods of increasing efficiency of wear resistance of tools equipped by PSFM during their diamond and abrasive processing, and based on their analysis defined the necessity of further study of this process with point of view of microrelief of cutting blade, chemical reactions existing in the machining zone were considered at the article.

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Робочі процесси високих технологій в машинобудуванні /Под ред. А.И. Грабченко.- Харків: ХДПУ, 1999.- 436 с.
- Інструменти из сверхтвердых материалов /Под ред. Н.В. Новикова.- Киев: ИСМ НАНУ, 2001.- 528 с.; ил.
- Лезвийний інструмент из сверхтвердых материалов: Справ. /Под общ. ред. Н.В. Новикова.- Київ: Техніка, 1988.- 118 с.
- Грабченко А.И., Семко М.Ф. и др. Алмазное шлифование синтетических сверхтвердых материалов.- Харьков, 1980.- 236 с.
- Борисов В.Д., Ященко П.И. Технологическое обеспечение качества рабочих кромок инструмента и деталей.- Мин.: БАТУ, 1997.- 251 с.

Надійшла до редколегії 16 грудня 2002р.

УДК 669.017

## ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ХАРАКТЕРИСТИК ТРИЦІНОСТІЙКОСТІ ПЕРКОЛЯЦІЙНО-ФРАКТАЛЬНИХ СИСТЕМ “ТРГ – КЕРАМІКА” МЕТОДОМ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ

І.Г. Грабар, д.т.н., проф.; О.А. Гутніченко, асист.  
(Харківський інженерно-технологічний інститут)

Відомо, що фізичні властивості композиційних систем провідник – ізолятор у залежності від властивостей вихідних матеріалів та технології виготовлення можна варіювати у широких межах, що значно розширює можливості використання даних матеріалів у різних галузях промисловості, але, з іншого боку, виникає ситуація, коли складно вибрати критерій оптимізації технології виготовлення даних матеріалів за структурними та провідними властивостями.

Враховуючи властивості структури композитів “термографеніт – кераміка”, а саме високу пористість, схильність до розтріскування у процесі срікання, для даних матеріалів як критерій оптимізації доцільно використовувати характеристики тріциностійкості, а саме  $K_{Ic}$ : коефіцієнт інтенсивності напруження, а також для повного бачення процесів руйнування об'єктів із тріциною доцільно дослідити кінетику деформування та руйнування даних матеріалів.

Для визначення граничних значень коефіцієнта інтенсивності напруження  $K_{Ic}$  використовувались дискові зразки діаметром 22-24 мм для змішування на позацентрове розтягнання, усі інші геометричні дані використовуваних зразків вибиралися із рекомендованих у [1].

Розрахунок відповідного коефіцієнта проводився за формулою [1]:

$$K_{Ic} = \frac{P_c}{t \cdot \sqrt{b}} \cdot Y\left(\frac{l}{b}\right),$$

де  $P_c$  – навантаження у момент розриву зразка, Н;

$t$  – товщина зразка, м;

$b$  – відстань до технологічних отворів, м;

$Y(l/b)$  – поправочна функція, яка визначається для даного типу зразків за формулою

$$Y(l/b) = \sqrt{\frac{l}{b}} \cdot \left[ 29,6 - 162 \frac{l}{b} + 492 \left(\frac{l}{b}\right)^2 - 663 \left(\frac{l}{b}\right)^3 + 405 \left(\frac{l}{b}\right)^4 \right].$$

Отримані експериментальні дані у залежності від технологічних режимів виготовлення зразків подані на рис.1.

Аналізуючи подані залежності, можна зробити такі зауваження та висновки:

1 Враховуючи, що коефіцієнт інтенсивності напруження досить гостро реагує на різноманітні зміни, можна зробити висновок, що тиск формоутворення майже не впливає на  $K_{Ic}$ .

2  $K_{Ic}$  більше залежить від часу, ніж від температури спікання.

3 Залежності коефіцієнта інтенсивності від концентрації ТРГ мають екстремум (мінімум) у точці  $t_{TRG}=0,21$ (мас.), дані залежності досить точно описуються квадратними рівняннями із мінімальним коефіцієнтом кореляції  $R=0,95$ .

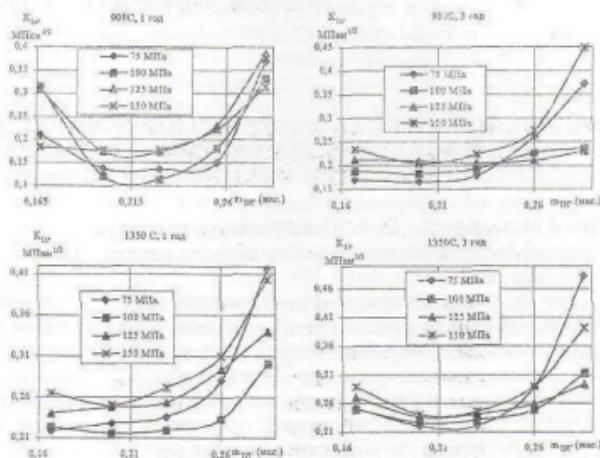


Рисунок 1 - Залежність коефіцієнта тріщиностійкості від технологічних режимів виготовлення матеріалу

4 На нашу думку, при низьких концентраціях  $K_{Ic}$  зростає за рахунок зміщення керамічного каркаса; після проходження мінімуму в області концентрацій  $0,21 < t_{TRG} < 0,29$  даний коефіцієнт зростає завдяки утворенню зони пластичності.

5 При підвищенні температурі та часі спікання, спостерігається зменшення значень  $K_{Ic}$  у області низьких концентрацій, що, очевидно, пов'язано із розтріскуванням керамічного каркаса.

Для дослідження кінетики процесів при деформуванні та руйнуванні композитів "ТРГ - кераміка" використовувалась експериментальна установка, схема якої подана на рис. 2, з якого бачимо, аналогово-цифровим перетворювачем (АЦП) вхідне падіння напруги при навантаженні ( $U_{ax}$ ) та падіння напруги на досліджуваному зразку ( $U$ ).

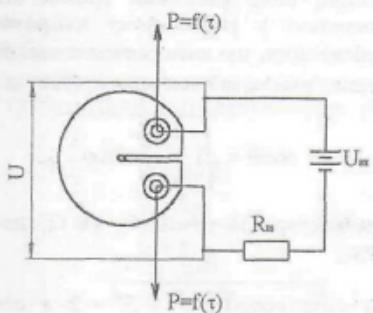


Рисунок 2 - Експериментальна схема досліджень кінетики деформування та руйнування зразків

Електричний опір у будь-який момент часу визначався за формулою

$$R = \frac{U \cdot R_w}{U_{ax} - U},$$

де  $R_w$  – електричний опір шунта, Ом.

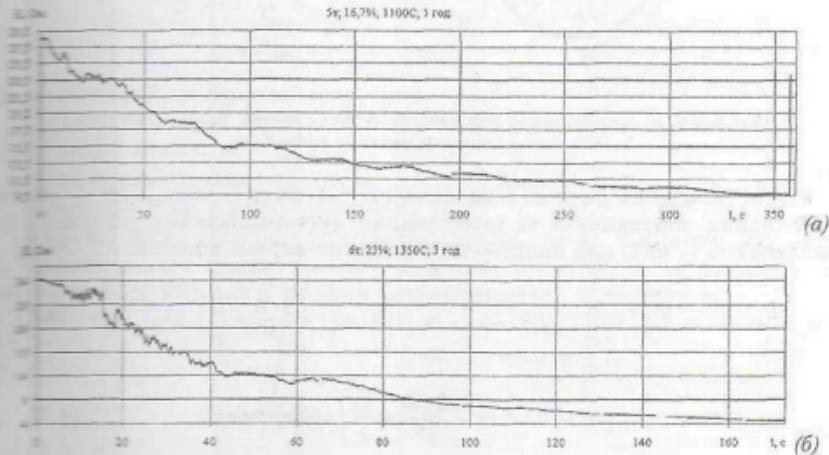


Рисунок 3 - Кінетичні залежності електричного опору при деформуванні та руйнуванні зразків. Швидкість навантаження 4 г/с. Діаметри, довжини надрізу, товщини зразків та розмір с, мм: а) 19,25, 11,0, 21,35; б) 22,55, 6,85, 18,45, 21,6 (дискретизація 1000 Гц)

У даній експериментальній схемі використовувалась властивість переключено-фрактальних середовищ, яким є досліджуваний матеріал, змінювати фізичні характеристики при незначних деформаціях [2]. Експериментальні результати подані на рис. 3, який свідчить, що для криві можна розділити на дві частини: деформування зразка до

критичного навантаження та безпосередньо руйнування зразка. Розглянемо їх окремо.

1 Кінетика деформування дискового зразка із тріщиною при позацентровому розтягуванні

Розглянемо ситуацію, коли дисковий зразок стискається в коловому напрямку та деформується у радіальному напрямку відносно точки  $O_2$  (кінець надрізу) під дією сили, що змінюється в часі  $P(t)$  (рис. 3).

Із рис. 4(a) знаходимо взаємоз'язок між кутами  $\varphi$  та  $\theta$  у вигляді

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \left( \frac{a}{R} \sin \varphi \right)^2}, \quad (1)$$

де  $a$  та  $R$  – радіуси-вектори із точок  $O_2$  та  $O_1$  до границі зразка. Тоді можемо записати, що

$$a = \sqrt{(\varepsilon \cdot \cos \varphi)^2 - \varepsilon^2 + R^2} - 2 \cdot s \cdot \cos \varphi, \quad (2)$$

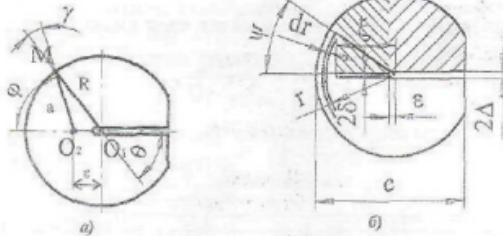


Рисунок 4: а) до визначення деформованого стану зразка; б) до визначення електричного опору зразка із тріщиною

Після складання рівнянь рівноваги для елементу із розмірами  $dr$  та  $d\varphi$  у полярних координатах та інтегрування диференціальних рівнянь, що випливають із них, для напружень отримаємо вирази відносно осі  $O_2$  [3]:

$$\sigma_r = \left( 2 \cdot A \cdot r - \frac{2 \cdot B}{r^3} + \frac{D}{r} \right) \cdot f_1(\varphi) \cdot \cos \gamma, \quad \sigma_\varphi = \left( 6 \cdot A \cdot r + \frac{2 \cdot B}{r^3} + \frac{D}{r} \right) \cdot f_1(\varphi) \cdot \cos \gamma, \quad (4.1)$$

$$\tau_{r\varphi} = - \left( 2 \cdot A \cdot r - \frac{2 \cdot B}{r^3} + \frac{D}{r} \right) \cdot f_2(\varphi) \cdot \cos \gamma. \quad (4.2)$$

Для деформацій отримаємо

$$\varepsilon_r = \frac{1}{E} \cdot (\sigma_r - \nu \cdot \sigma_\varphi), \quad \varepsilon_\varphi = \frac{1}{E} \cdot (\sigma_\varphi - \nu \cdot \sigma_r). \quad (5.1)$$

Постійні інтегрування знаходяться із таких умов:

$$\sigma_r = \tau_{r\varphi} = 0 \text{ при } r=R \text{ та } \int_0^R r_{r\varphi} dr = P(t).$$

Отже, ми отримали деформаційне поле зразка у будь-який момент часу навантаження. Електричний опір трубки течії товщиною  $dr$  та довжиною  $rd\phi$  визначатиметься за формулою

$$R = R_0 \cdot \left( \frac{1 + \varepsilon_\varphi}{1 + \varepsilon_r} \right) \quad (6)$$

де  $R_0$  – початковий опір елемента;

$R$  – опір після деформації.

За умови, що осі трубки течії паралельні, для електричного опору усього зразка маємо

$$R_\Sigma = \int_0^{2\pi} \frac{\frac{d\theta}{d\varphi}}{\int_0^a \frac{1}{R} dr} d\varphi, \quad (7)$$

де  $a$  визначається за формулою (2).

2 Кінетика зростання тріщини при позацентровому розтягуванні дискового зразка

Визначимо електричний опір зразка при виникненні та зростанні у ньому тріщини за наявності початкового надрізу рис. 4, б.

Виділимо елементарну площину ширину  $dx$ , тоді, очевидно, що опір зразка на ділянках  $x \in (-\varepsilon; c-R)$  (область надрізу) та  $x \in (-\xi; \varepsilon)$  визначатиметься за формулою

$$dR_1 = \frac{2 \cdot \rho}{t} \cdot \frac{dx}{\sqrt{R^2 - x^2 - \Delta}}, \quad dR_2 = \frac{2 \cdot \rho}{t} \cdot \frac{dx}{\sqrt{R^2 - x^2 - \delta}}, \quad (8.1)$$

де  $\rho$  – питомий електричний опір, Ом·м;

$\delta$  – ширина зразка, м;

$R$  – радіус зразка, м;

$\Delta$  – половина ширини надрізу, м,

$\xi$  – ширина тріщини при руйнуванні, м.

Для ділянки  $x \in (-R; -\xi)$  розглянемо трубку течії ширину  $dr$ , яка проходить вздовж твірної зразка у межах кута  $(-\psi; \psi)$ , як це показано на рис. 4, б. Тоді опір даної ділянки визначатиметься за формулою

$$R_3 = \frac{1}{\int_{-R}^{-\xi} \frac{t \cdot dr}{2 \cdot \rho \cdot r \cdot \psi}}, \text{ де } \psi = \arccos\left(\frac{\xi}{R}\right). \quad (8.2)$$

Тоді загальний електричний опір зразка складатиме

$$R_\Sigma = R_1 + R_2 + R_3. \quad (9)$$

Після розрахунків за формулами (9) та після порівняння із графіками залежності електричного опору зразків від часу в момент розриву (рис. 5) отримаємо залежність зростання ефективної довжини тріщини від часу (рис. 6).

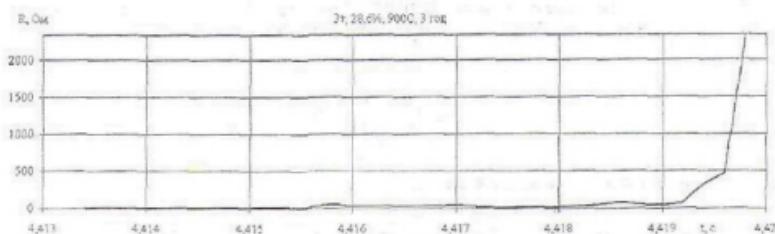


Рисунок 5 · Залежність електричного опору зразків від часу в момент розриву  
(дискретизація 5000 Рц)

Слід зазначити, що дані на рис. 6 розраховувались для ідеалізованої моделі, у якої тріщина при розриванні зростала у напрямку осі та форма тріщини паралельна їй, тому розрахована довжина  $l_e$  є ефективною довжиною (або, з іншого боку, проекцією дійсної довжини тріщини на вісь).

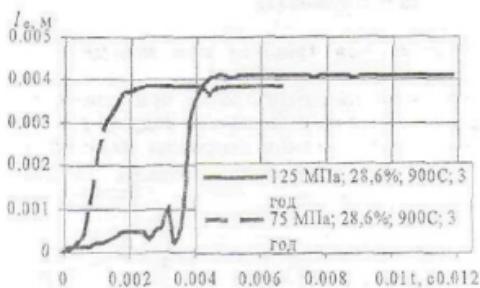


Рисунок 6 · Кінетика зростання ефективної довжини тріщини

Аналізуючи рис. 6, видно, що розрив зразків відбувається стрибкоподібно, причому швидкості розриву майже однакові (без урахування плавкої ділянки у кривої 125 МПа), а також можна зробити висновок, що тиск пресування значно впливатиме на тривалість процесу руйнування.

Загалом, на основі отриманих експериментальних даних, можна зробити висновок про доцільність використання електрических методів для дослідження кінетики характеристик руйнування переколіячно-фрактальних матеріалів.

## SUMMARY

*The coefficients of stress intensity  $K_{Ic}$  of the composites "TEG - ceramics" were determined by experiment depending on concentration of TEG and operating modes of manufacture of these materials. The kinetics of warping and destruction of materials during of eccentric tension was considered by electrical methods, and on its basis the calculations were carried out and the rates of increase of effective length of crack during of destruction was determined.*

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Механика разрушения и прочность материалов: Справ. пособие: В 4 т. /Под общей ред. Панасюка В.В. – Киев: Наук. думка, 1988. - Т. 3: Характеристики кратковременной трещиностойкости материалов и методы их определения /Крачник С.Е., Морозов Е.М. – 1988. – 436 с.

2. Грабар І.Г. Переконні-фрактальні матеріали - надперспективні матеріали для тензометричних датчиків-перетворювачів //Вісник ЖІТІ, 1995. - №6.-С. 3-6.
3. Подгорний А.Н., Марченко Г.А., Пустынников В.И. Основы и методы прикладной теории упругости: Учеб. пособие для вузов. - Киев: Выща школа. Головное изд-во, 1981.- 328 с.

Надійшла до редколегії 16 грудня 2002р.

УДК 621.91

## ПУТИ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРИ ПОМОЩИ ТЕОРИИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

А.Н. Грабченко, д.т.н. проф.; Д.Б. Романенко, асп.

(Харьковский национальный технический университет «ХПИ»)

В начале восьмидесятых годов в исследованиях по искусственному интеллекту сформировалось самостоятельное направление, получившее название "экспертные системы" (ЭС). Цель исследований по ЭС состоит в разработке программ, которые при решении задач, трудных для эксперта-человека, получают результаты, не уступающие по качеству и эффективности решениям, получаемым экспертом. Исследователи в области ЭС для названия своей дисциплины часто используют также термин "инженерия знаний", введенный Е. Фейгенбаумом как "привнесение принципов и инструментария исследований из области искусственного интеллекта в решение трудных прикладных проблем, требующих знаний экспертов".

Программные средства (ПС), базирующиеся на технологии экспертных систем, или инженерии знаний (в дальнейшем будем использовать их как синонимы), получили значительное распространение в мире. Важность экспертных систем состоит в следующем:

- технология экспертных систем существенно расширяет круг практически значимых задач, решаемых на компьютерах, решение которых приносит значительный экономический эффект;
- технология ЭС является важнейшим средством в решении глобальных проблем традиционного программирования: длительность и, следовательно, высокая стоимость разработки сложных приложений;
- высокая стоимость сопровождения сложных систем, которая часто в несколько раз превосходит стоимость их разработки; низкий уровень повторной используемости программ и т.п.;
- объединение технологии ЭС с технологией традиционного программирования добавляет новые качества к программным продуктам за счет обеспечения динамичной модификации приложений пользователем, а не программистом, большей "прозрачности" приложения, лучшей графики; интерфейса и взаимодействия.

По мнению ведущих специалистов, в недалекой перспективе ЭС найдут следующее применение:

- ЭС будут играть ведущую роль во всех фазах проектирования, разработки, производства, распределения, продажи, поддержки и оказания услуг;

- технология ЭС, получившая коммерческое распространение, обеспечит революционный прорыв в интеграции приложений из готовых интеллектуально-взаимодействующих модулей.

ЭС предназначены для так называемых неформализованных задач, т.е. ЭС не отвергают и не заменяют традиционного подхода к разработке